

عنوان مقاله:

بلور فوتونیکی یک بعدی شامل مواد تک منفی با سه لایه در سلول واحد

محل انتشار:

پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (سال: 1387)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

عبدالرحمن نامدار - گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

غفور خاندی - گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

خلاصه مقاله:

در این مقاله ویژگی های گافهای باند در یک بلور فوتونیکی یک بعدی سه لایه ای سه لایه در هر تناوب شامل مواد اپسیلون - منفی . مو - منفی و معمولی بررسی می شود نشان می دهیم که با افزایش ضخامت لایه معمولی هر دو لبه گاف فاز صفر لایه بالایی گاف زاویه ای به بسامدهای پایین تر جابجا می شوند همچنین مطالعات ما نشان می دهد که لبه بالایی گاف زاویه ای با افزایش زاویه تابش به بسامدهای بالاتر انتقال می یابد در صورتی که در مورد گاف فاز صفر یکی از لبه ها مستقل از زاویه تابش است و جابجایی لبه دیگر آن با افزایش زاویه تابش به ضخامت لایه معمولی بستگی دارد .

کلمات کلیدی:

بلور های فوتونیکی ، گاف باندهای فوتونیکی ، متامواد تک - منفی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/65087>

